

NUBIC知的財産情報開示

開示日：2002年12月06日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

NUBIC管理番号：2001000110

表題	半導体素子の薄膜製造方法			
技術分野	電気・電子	半導体素子	ULSI	
適応製品	半導体素子 (ULSI ultra-large-scale-integration), 情報通信機器			
目的	携帯電話やパソコン等の情報通信分野における機器の軽量化, 小型化, 高速化, 大容量化のニーズによるS 高集積化素子の集積度の向上は著しく, トランジスタ部のゲート絶縁膜の薄膜化により, 新奇な機能材料が求められている。本発明は、この課題の解決方法を提供する。			
技術概要	S 集積回路のトランジスタ部のゲート絶縁膜に, SO_2 及び Al_2O_3 の二重構造の薄膜を熱酸化法で形成することを特徴とする。 自然酸化膜を除去した状態で, Al原子を添加したRCAアルカリ洗浄でSiウェーハを処理し, 熱酸化する。Alは Al_2O_3 となって, SO_2 と2層構造を形成する。 Al_2O_3 の比誘電率は SiO_2 より高いので, より高性能のゲート酸化膜が作製可能である。			

整理番号 10269 担当者 片山 充子

技術移転等をご希望の場合は, 下記事項をご記入の上, 本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を申し上げます。

面談希望日時			
(ふりがな) 氏名			
会社名			
所属		役職	
電話番号		FAX番号	
E-mail			
連絡事項			

【 申込み・問い合わせ先 】

日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南 4- 8- 24 日本大学会館

TEL :03-5275-8139 FAX :03-5275-8328 e-mail :nubic@adm.nihon-u.ac.jp

